

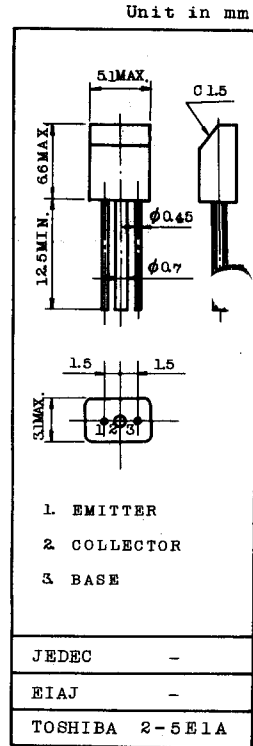
2SA509

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 低周波電力増幅用
 - Audio Power Amplifier Applications
 - ・ B級プッシュプルで1Wの出力が得られます；
 - ・ 2SC509とコンプリメンタリになります；
 - ・ 1 Watt Amplifier Applications
 - ・ Complementary to 2SC509

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-35	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-30	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-500	mA
エミッタ電流	I _E	500	mA
コレクタ損失	P _C	600	mW
接合温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ 150	°C



アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

※ PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SA509

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	ICBO	V _{CB} = -20V I _E = 0	-	-	-100	nA
エミッタしや断電流	IEBO	V _{EB} = -5V I _C = 0	-	-	-100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C = -10mA I _B = 0	-30	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E = -0.1mA I _C = 0	-5	-	-	V
直 流増幅率 (Note)	h _{FE}	V _{CE} = -2V I _C = -50mA	70	100	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -500mA I _B = -20mA	-	-0.3	-0.8	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} = -10V I _E = 10mA	-	140	-	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = -10V I _E = 0 f = 1MHz	-	22	30	pF

Note: h_{FE}により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE}, the 2SA509 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA509 - 0	70	140
2SA509 - Y	120	240

2SA509

STATIC CHARACTERISTICS

